

Волківський С.В., магістрант, ФІКТ, гр. ТТ-6м
 Науковий керівник: Манойлов В.П., д.т.н., професор
 Житомирський державний технологічний університет

**ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСМУЖКОВОГО ВІБРАТОРА
 В ШАРУВАТОМУ СЕРЕДОВИЩІ**

Мікросмужкові вібратори представляють один з основних типів мікросмужкових антен і знаходять практичне застосування, як у якості самостійних антен, так і в складі більш складних антенних структур і антенних решіток. Використання складових лінійних і навантажених вібраторних структур дозволяє змінювати їх електродинамічні характеристики і розширює можливості застосування антен цього типу. Аналіз МСВ, особливо, дослідження їх граничних електродинамічних характеристик, вимагає побудови адекватних математичних моделей і побудови ефективних алгоритмів чисельного дослідження. Основою останніх є редукція граничних задач електродинаміки до інтегральних рівнянь. Чисельний аналіз мікросмужкового вібратора в шаруватому середовищі доцільно проводити на основі одновимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду для його повного струму, що й буде розглянуто в даній роботі.

Розглядається наступна задача електродинаміки. В середовищі з плоским шаруватим заповненням (рис.1) на одній з границь середовища розташований стрічковий провідник, який представляє мікросмужковий вібратор з шириною $2d$ і довжиною $2L$.

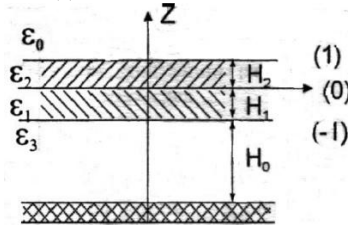


Рис.1. Середовище з плоским шаруватим заповненням

Вібратор має вигляд тонкого стрічкового провідника (рис.1) з шириною $2d$ і довжиною $2L$, стрічкові провідники утворюють плечі вібратора з зазором (щілиною) між ними розміром $2b$.

Передбачається, що виконуються умови $kd \ll 1$, $kb \ll 1$, $kL > 1$, де $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, λ – робоча довжина хвилі.

Збудження вібратора забезпечується різницею потенціалів U на його вході, при якій в області щілини встановлюється первинне поле E^z . Беручи до уваги розміри вібратора в області щілини і припускаючи його ефективне збудження, розрахунок поля E^z можна провести в квазістатичному наближенні

$$E^z(x, y) = -\frac{Ud}{\pi\sqrt{d^2 - y^2}\sqrt{b^2 - x^2}}; |x| \leq b, |y| < d \quad (1)$$

Одновірне інтегральне рівняння для повного струму вібратора $I(x_0)$ має вигляд:

$$\int_{-L}^L I(x_0)G(x, x_0)dx_0 = -i\frac{2\pi}{W} \int_{-b}^b E^z(u) \sin|u - x|du + C_1 \sin x + C_2 \cos x \quad (2)$$

де ядро рівняння

$$G(x, x_0) = G(x, x_0) + \frac{\partial g(x, x_0, z)}{\partial z} - \frac{1}{2} \int_{-L}^{\sin L} |x - u| \frac{\partial g(x, x_0, z)}{\partial z} du \quad (3)$$

Для первинного поля (1) рівняння (2) приймає вигляд

$$\int_{-L}^L I(x_0)G(x, x_0)dx_0 = -i\frac{2\pi}{W} U J_0 \sin|x| + C_1 \sin x + C_2 \cos x \quad (4)$$

де $W = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} J_0(b)$ - функція Бесселя нульового порядку;

U - різниця потенціалів на вході вібратора.

Приводимо основні вирази для елементів тензорної функції Гріна шаруватого середовища, які визначають ядро (3) інтегрального рівняння (4). Для випадку шаруватого середовища, одержимо при

$$G_0(\rho) = \frac{e^{-ik_2\rho}}{\rho} = \int_0^\infty f_G(\lambda) J_0(\lambda\rho) \frac{\lambda}{\eta_2} d\lambda;$$

$$\left. \frac{\partial G^{(R)}}{\partial z} \right|_{z=0} = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} G_0(\rho) + \int_0^\infty f_E(\lambda) J_0(\lambda\rho) d\lambda;$$

де

$$f_G = R_H^{(0)} \frac{1 + R_H^{(1)} e^{-2\eta_2 H_2}}{1 - R_H^{(1)} R_H^{(0)} e^{-2\eta_2 H_2}} + R_H^{(1)} e^{-2\eta_2 H_2} \frac{(1 + R_H^{(0)})}{1 - R_H^{(1)} R_H^{(0)} e^{-2\eta_2 H_2}};$$

$$f_E = -\frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} \frac{1 + R_H^{(0)} + R_H^{(1)} (1 + R_H^{(0)}) e^{-2\eta_2 H_2}}{1 - R_H^{(1)} R_H^{(0)} e^{-2\eta_2 H_2}} \frac{\lambda}{\eta_2} -$$

$$-\frac{\eta_2}{\lambda} \frac{R_H^{(0)} - R_H^{(1)} (1 + R_H^{(0)}) e^{-2\eta_2 H_2}}{1 - R_H^{(1)} R_H^{(0)} e^{-2\eta_2 H_2}} + \frac{\eta_2}{\lambda} \frac{R_E^{(0)} - R_E^{(1)} (1 - R_E^{(0)}) e^{-2\eta_2 H_2}}{1 - R_H^{(1)} R_H^{(0)} e^{-2\eta_2 H_2}}.$$

Зокрема, для випадку діелектричного шару з цих виразів для ядра інтегрального рівняння (4) можна отримати елементи при $|x - x_0| = \xi$:

$$G_0(\xi) = P(\xi) + \int_0^\infty R_H^{(0)} J_0(\lambda\xi) \frac{\lambda}{\eta_2} d\lambda;$$

$$\left. \frac{\partial G(\xi, z)}{\partial z} \right|_{z=0} = -\frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} \left[G_0(\xi) - \int_0^\infty [(1 + R_H^{(0)}) J_0(\lambda\xi) \frac{\lambda}{\eta_2} d\lambda] - \int_0^\infty [(R_H^{(0)} - R_E^{(0)}) J_0(\lambda\xi) \frac{\eta_2}{\lambda} d\lambda \right], \quad (5)$$

коефіцієнти визначаються

$$P(\xi) = \frac{e^{-i\xi}}{\sqrt{\xi^2 + d^2}} \left[(1 + i\xi) \frac{2}{\pi} F\left(\frac{\pi}{2}, \alpha\right) - i\sqrt{\xi^2 + d^2} \right],$$

де $\eta_0 = \sqrt{\lambda^2 + \varepsilon_0}$; $\eta_1 = \sqrt{\lambda^2 - \varepsilon_1}$; $\varepsilon_1, \varepsilon_0$ - діелектричні проникності граничних середовищ;

$F\left(\frac{\pi}{2}, \alpha\right)$ - повний еліптичний інтеграл першого роду;

$$\alpha = \frac{d}{\sqrt{\xi^2 + d^2}}.$$

Отже, ядро (3) інтегрального рівняння (4), враховуючи представлення елементів тензора (5), має логарифмічну особливість. Це визначає інтегральне рівняння (4) як інтегральне рівняння Фредгольма першого роду для повного струму мікросмужкового вібратора.

В результаті досліджень наведено приклади розрахунку вхідного імпедансу вібратора для різних параметрів шаруватого середовища, що складають його підкладку і укриття, що змінюють частотні властивості мікросмужкового вібратора. Показано, що використання багат шарових середовищ, в якості підкладки і укриття мікросмужкового вібратора, дозволяють змінювати електричну довжину вібратора і його частотні властивості.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:

ВОЛКІВСЬКИЙ Сергій Володимирович, магістрант групи ТТ-6м кафедри радіотехніки, радіоелектронних апаратів і телекомунікації Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси: інтернет технології.

МАНОЙЛОВ В'ячеслав Пилипович – д.т.н, професор, завідувач кафедри радіотехніки, радіоелектронних апаратів і телекомунікації Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси: пристрої НВЧ та антени.

e-mail: rt_i_t@mail.ru.